بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات TiO2 بر روی هدایت الکتریکی نانو کامپوزیت RGO-ZnO

نجمه لطفیان^۱، امیرعباس نوربخش ^۲*، پریسا مشایخی^۳، سارا عباسپور^۴، سید مهدی میرهادی^۵، سعید جبار زارع^۶ ۱- دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۲- دانشیار، گروه مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۳- کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- مارنای ارشد، گروه مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- ماری، گروه مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- مربی، گروه مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۲باد، ایران ۵- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۴- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران ۲- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکاه مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف ۲- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکاه مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران ۲- مربی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکنه مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده: پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی هدایت الکتریکی نانو کامپوزیت RGO-ZnO-TiO2 در مقایسه با نانو کامپوزیت RGO-ZnO می باشد. در راستای انجام این پژوهش ابتدا گرافن اکساید با استفاده از روش هامر اصلاح شده سنتز و جهت تبدیل به گرافن اکساید احیاشده (RGO) توسط روش سل ژل انجام شد. جهت مشخصه یابی نانو ذرات سنتز شده، این نانو ذرات تحت آنالیز فازی DRSUV، XRD و TiO2 قرار گرفت. و سنتز این فران یا می منخصه یابی نانو ذرات سنتز شده، این نانو ذرات تحت آنالیز فازی DRSUV، XRD و TiO3 قرار گرفتند و سنتز این نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه های نانو کامپوزیتی DRSUV، XRD و TiO3 قرار گرفتند و سنتز این نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه های نانو کامپوزیتی DRSUV، XRD و RGO-ZnO قرار گرفتند و سنتز این نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه های نانو کامپوزیتی PTO-TiO2 میزان باند گپ توسط روش سل ژل انجام وری، نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه های نانو کامپوزیتی PTO-TiO2 و RGO-ZnO قرار گرفتند و سنتز این نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه های نانو کامپوزیتی دوست. معانه از میزان باند گپ توسط روش تاک نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه های نانو کامپوزیتی PTO-TiO2 و میزان باند گپ توسط روش تاک نانو ذرات PTO محکمه و محرف به TiO2 و می شیشه PTO پوشش داده شدند و میزان باند گپ توسط روش تاک پردی، نانو ذرات PTO محکمه این این و می محاسبه ودو نمونه باند گپ توسط روش تاک توری، نانو ذرات PTO محکمه و تاین و تراک PTO معاری مراد مقایسه این دو نمونه به ۲۰۱۰ هم به ۲۰۱۰ هم به ۲۰۱۰ هم می گردد. با بررسی سطوح انرژی نانو درات PTO محکم و ترژی نانو درات PTO محمور نور VU نسبت مقاومت از ۲۰۱۰ ۳۸۸ هم به ۲۰۱۰ هم می گردد. با بررسی سطوح انرژی نانو درات PTO و می محاسب به در PTO و عدم توانایی الکترون درات PTO محمور نور VU و کاهش شدید مقاومت به بالاتر بودن سطح انرژی PTO ممی گردد. با بررسی سطوح انرژی PTO محمور نور VU و کاهش شدید مقاومت تو تاید و توان مر PTO ممی به در JU و کاهش شدید محمور نور VU و کاهش شدید مونه تحت نور VU و کاهش محمور نور VU و کاهش محمور نور VU و کاهش مدان این نمونه تحت نور VU و کاهش مدی محمور تور VU و کاهش مدان مدا این نمونه تحت نور VU و کاهش مدی محال و تاین محمور م

واژەھاي كليدى:

نانو كامپوزيت، RGO-ZnO، هدايت الكتريكي، TiO₂، طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي.

۱-مقدمه

(در حدود 1TPa)، ضریب هدایت حرارتی بالا (در حدود W m⁻¹)، ضریب هدایت حرارتی بالا (در حدود K⁻¹). K⁻¹ K⁻¹) و انتقالات اپتیکی در حدود ۹۷/۷ ٪ می باشد [۱]. m² g⁻¹) گرافن یک ماده ی شگفت انگیز با سطح ویژه بالا (¹ g⁻¹) گرافن یک ماده ی شگفت انگیز با سطح ویژه بالا (۲۶۳۰)، مدول یانگ بالا

از میان تمام ویژگیها، گرافن قابلیت جذب فوتون را در محدوده نور مرئی تا فروسرخ دارا میباشد که این ویژگی، گرافن را برای کاربردهای فتوولتائیک جذاب ساخته است[۲]. یکی از روشهای سنتز گرافن از اکسید گرافیت می باشد. در این روش گرافیت را اکسید میکنند و در یک محیط اسیدی قوی لایه هایی را به صورت اکسید گرافن (GO) جدا می کنند. در این فرایند، گروههای عاملی اکسیژن دار بسیاری (مانند کربو کسیل، اپو کسید و گروه های هیدرو کسیل) در سطح گرافن ایجاد می گردد. واقعیت نامطلوب در مورد GO این است که حضور گروه های عاملی در سطح GO باعث عایق شدن الکتریکی آن می گردد لذا با کاهنده هایی نظیر هیدرازین یا حرارت دهی تحت یک اتمسفر احیا کننده یا تحت نور UV، احیا می کنند تا به ساختار اصلی گرافن نزدیک تر شوند. با اینکه فرآیند احیا کردن به مقدار زیادی هدایت گرافن را باز می گرداند اما محصول نهایی هنوز مقادیر قابل توجهی پیوندهای کربن- اکسیژن داشته و از خواص اصلی گرافن فاصله دارد ولی فرآيند تهيه آن نسبت به گرافن ساده تر مي باشد [۳-۴] .

یکی از فعالیت های جذاب در این زمینه، ترکیب نانو ساختارهای دو بعدی کربن با اکسیدهای فلزی همچون ZnO و TiO2 است، که مواد هیبریدی با کاربردهای جدید را ایجاد کند[۵–۶].

ایکس یو و همکارانش ⁽ [۷] گزارش نمودند که کامپوزیت گرافن-ZnO بهبود فوتوکاتالیستی را در تخریب رنگ آلی در مقایسه با ZnO خالص نشان داده است. در سال ۲۰۱۲ نیز لیو^۲ و همکارانش [۸-۹] نشان دادند که کامپوزیت RGO-ZnO نسبت به ZnO خالص خاصیت فوتوکاتالیستی بهتری را نشان داد که این افزایش خاصیت فوتوکاتالیستی به شدت نور جذب شده و کاهش بازترکیب الکترون و حفره در ZnO در اثر القای RGO به کامش بازترکیب الکترون و حفره در ZnO در اثر القای RGO به ZnO نسبت داده می شود. در چنین مواد هیبریدی بر پایه گرافن، ZnO به عنوان عامل فوتوکاتالیست جهت انتقال الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت و ایجاد جفت الکترون – حفره ایفای نقش می کند و گرافن به عنوان یک ماده هدایت کننده

عالی باعث تسهیل انتقال محرک های الکترونی و به تاخیر انداختن بازترکیب الکترون و حفره می شود. این موضوع باعث افزایش عملکرد فوتوکاتالیستی ZnO می گردد. اما متاسفانه باز هم این بازترکیب الکترون و حفره در کامپوزیت RGO-ZnO قابل مشاهده خواهد بود که باعث کاهش عملکرد فوتوکاتالیستی این مواد می گردد. لذا طراحی و توسعه مواد هیبریدی بر پایه RGO-ZnO-TiO₂ به دلیل ساختار مرتبهای باندگپ می تواند یک راه حل امیدوارکننده برای حل این مشکل باشد [۵].

از جمله تحقیقاتی که در این زمینه صورت پذیرفته شده است می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:

ليو و همكارانش [۵] در سال ۲۰۱۳ به بررسی خاصيت فوتوكاتاليستى نانو كامپوزيت RGO-ZnO-TiO₂ پرداختند و نشان دادند كه اين نانو كامپوزيت خواص فوتوكاتاليستي بهتري نسبت به نانو کامپوزیت RGO-ZnO و نانو ذرات ZnO را دارا میباشد. مدهوان " و همکارانش [۱۰] نیز نانو کامپوزیت graphene-ZnO-TiO₂ را برای کاربردهای پزشکی و فوتولتائیک مطرح نمودند. از دیگر پژوهش.های انجام شده در این زمینه می توان به بررسی های جوه را ^۴ و همکارانش [۱۱] در سال ۲۰۱۵ اشاره نمود که این تیم به سنتز و مشخصه یابی و همچنین بررسی،های فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت RGO-ZnO-TiO₂ پرداختند و نشان دادند که فعالیت فوتوكاتاليستى اين نانو كامپوزيت در مقايسه با ZnO يا TiO₂ خالص و یا کامپوزیت TiO2-ZnO بهبود یافته است که علت این افزایش خاصیت فوتوکاتالیستی به شدت نور جذب شده بیشتر و کاهش بازتر کیب الکترون و حفره نسبت داده می شود. علی رغم مطالعات انجام گرفته نقش ساختارهای هیبریدی نانو سایز اکسیدی بر هدایت الکتریکی، فوتوکاتالیستی و..... به وضوح در منابع مطالعاتي يافت نمي شود.

لذا در تحقیق حاضر سعی بر شاخصه یابی و بررسی هدایت الکتریکی نانو کامپوزیت RGO-ZnO-TiO2 و RGO-ZnO به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، DRSUV شده است.

۲- مواد ور وش انجام تحقیق ۲-۱- سنتز نانو ذرات گرافن اکساید احیا شده(RGO)

جهت سنتز نانو ذرات گرافن اکساید احیا شده، ابتدا نانوصفحات گرافن اکساید، با استفاده از روش هامر اصلاح شده [۲] سنتز گردید و سپس با استفاده از روش های احیا گرافن اکساید به گرافن اکساید احیاشده(RGO) تبدیل شد. یکی از روشهای احیای گرافن اکساید استفاده از نور UV و دما بوده که در پژوهش حاضر، نمونه ها به مدت ۱۸ ساعت تحت دو لامپ راV، W۵ قرار گرفته و سپس به مدت ۳۰ دقیقه تحت اتمسفر آرگون احیا صورت پذیرفت.

برای سنتز گرافن اکساید ابتدا اگرم گرافیت را در ۲۳ میلی لیتر اسید سولفوریک حل کرده و سپس ۵/۰ گرم سدیم نیترات را به آن اضافه کرده و به مدت ۱۰ دقیقه واکنش تحت هم زدن شدید قرار گرفت، سپس نمونه را در حمام یخ در دمای ۰–۵ درجه سانتیگراد قرار داده و ۳ گرم پتاسیم پرمنگنات ، طی ۲ ساعت به آرامی به آن اضافه شد. سپس محفظه را از حمام یخ خارج کرده و فرآیند در دمای ۳۵ درجه به مدت نیم ساعت ادامه یافت. در مرحله بعد ۴۶ میلی لیتر آب دوبار تقطیر به آن اضافه گردید و با توجه به گرمازا بودن واکنش در دمای ۸۸ درجه سانتیگراد به افزودن ۱۴۰میلی لیتر آب دوبار تقطیر و ۱۰ میلی لیتر هیدروژن مدت ۳۰ دقیقه نگه داشته شد. در آخرین مرحله سنتز واکنش با یراکساید ۱۰٪ حجمی متوقف گردید، رنگ محلول در این یون های اضافی و واکنش نکرده مراحل شست و شو توسط سید هیدروکلریدریک ۵٪ و آب دی یونیزه انجام شد[۲].

۲-۲- سنتز نانو ذرات اکسید روی

برای سنتز نانو ذرات ZnO در مرحله اول باید به صورت مجزا ۲۰ گرم سدیم هیدروکساید را در ۳۰ میلی لیتر اتانول حل کرده و سپس در محفظه ای دیگر ۱۴/۷۵ گرم زینک استات ۲ آبه را در ۶۰ میلی لیتر اتانول حل کرده وپس از آن به صورت مجزا به مدت ۱ ساعت در التراسونیک قرار گرفت. سپس این دو محلول

با یکدیگر مخلوط شده و به مدت ۷۲ ساعت در دمای ۶۰ درجه تحت هم زدن قرار گرفت و سپس توسط اتانول و آب دی یونیزه مراحل شست و شو انجام گرفت [۱۲].

۲-۳- سنتز نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید

ابتدا ۵ میلی لیتر تیتانیوم ایزوپروپکساید در ۱۰۰ میلی لیتر ایزوپروپیل الکل توزیع گردید و به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق هم زده شد،سپس به صورت ناگهانی ۴۰۰ میلی لیتر آب دو بار تقطیر جهت عملیات هیدرولیز به محلول فوق اضافه شده و به مدت ۳ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفت و در دمای اتاق خشک گردید سپس به مدت ۲ ساعت در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد کلسینه گردید [۱۳].

۲-۴- آماده سازی نمونه

از پودر TiO₂-ZnO-RGO در سه محفظه مجزا سوسپانسیونی تهیه گردید، ابتدا سوسپانسیون گرافن اکساید آماده شده با روش غوطه وری بر روی شیشه FTO پوشش داده شده و بعد از آن سوسپانسیون ZnO نیز باروش غوطه وری به عنوان لایه دوم بر روى RGO نشانده شد. از نمونه RGO-ZnO سل الكتروشيميايي جهت آنالیز طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ساخته شد و مورد بررسی قرار گرفت. در گام بعد یک لایه از سوسپانسیون TiO₂ بر روی نمونهRGO-ZnO با روش غوطه وری پوشش داده شد و مجددا مورد آنالیز طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی قرار گرفت. در تحقیق حاضر جهت بررسی آنالیز فازی نمونه ها، الگوی تفرق اشعه X از دستگاه (XRD) با لامپ مس، Germany D8ADVANCE با طول موج A° 1/5406 با و فیلتر نیکل، به منظور تشخیص نوع پیوندهای تشکیل شده و بررسی گروه های عاملی از آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، از دستگاه اسیکتروفو تومتر UV-Vis مدل JASCO V-670 (190-2700 nm), Japan استفاده شد. باند گپ نمونه ها توسط روش تاک پلات بر اساس رابطه ۱ محاسبه گردید [۱۴].

$$A (h v - Eg) = (hv\alpha)^{1/n}$$
 (1)

که در این رابطه h ثابت پلانک، v فرکانس، α ضریب جذب ، Eg باندگپ، A ثابت و n نشان دهنده ی ماهیت انتقال الکترون است که بین 1/2 تا 3 متغیر است. میزان باندگپ از نقطه ی تقاطع خط مماس بر منحنی(²α بر حسب Eg) با محور افقی محاسبه می شود. جهت بررسی میزان هدایت الکتریکی از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) از دستگاه Princeton Applied Research مدل 2273 PARSTAT برای بررسی ریزساختار

نمونه ها از آنالیز FE-SEM با مدل MIRA3TESCAN-XMU و برای احیا نمونه ها از لامپ UV 30W استفاده گردید.

۳- نتایج و بحث
۳-ا- بررسی الگوی تفرق اشعه ۲، گرافیت ، گرافن اکساید
و گرافن اکساید احیا شده، تیتانیوم دی اکسید و اکسید
وی و کامپوزیت RGO-ZnO-TiO2
شکل ۱ الگوی پراش پرتو اشعه ۲ گرافیت، گرافن اکساید و
گرافن اکساید احیا شده را نشان می دهد.



شکل(۱): الگوهای پراش اشعه X از نمونه های: (الف): گرافیت، (ب): گرافن اکساید و (ج): گرافن اکساید احیا شده

الگوی پراش اشعه X نانو ذرات ZnO و TiO2 نیز به ترتیب در شکل (۲–الف) و (۲–ب) آورده شده است و همان طور که مشخص است به ترتیب در شکل(۲–الف) و (۲–ب) ،تمامی پیک های موجود در طیف پراش به خوبی تشکیل و حضور فاز

ورتزایت اکسید روی و فاز آناتاز اکسید تیتانیوم را بدون حضور هیچ گونه ناخالصی نشان میدهد.



شکل(۲): الگوهای پراش اشعه x از نمونه های: (الف): ZnO و (ب): TiO2

شکل ۳ نشان دهنده ی الگوی پراش اشعه X نمونه -RGO-ZnO حضور این فازها در نمونه RGO-ZnO-TiO₂ باشد. همچنین حضور فاز آمورف در این تصویر به حضور گرافن اکساید احیا TiO₂ می باشد که به خوبی حضورهم زمان فازهای ZnO وTiO₂ در الگوی XRD نشان داده شده است که می تواند دلیلی بر شده نسبت داده می شود. Intensity (a.u.) :TiO2 : ZnO 50 10 40 60 20 30 Position [°2Theta]

شكل(۳):الگوى پراش اشعه X(XRD) از نمونه RGO-ZnO-TiO2

Cm⁻¹ نشان می دهد. در تمامی نمونهها یک پیک ^۲-Cm ۱۰۷۰ مربوط به گروه عاملی C-O می باشد. پیک دیگر که در طول موج ۲-۱۷۳۰ مشاهده می گردد مربوط به گروه عاملی کربوکسیل (C=O) است که این پیک در نمونه (گرافن اکساید احیا شده توسط نور UV به همراه دما) دارای شدت کمتری **۲-۳- بررسی طیف FTIR گرافیت ،گرافن اکساید و** گرافن اکساید احیا شده

جهت بررسی گروههای عاملی، حاوی اکسیژن متصل به سطح جاذب از آنالیز FTIR استفاده شد. شکل۴آنالیز FTIR نمونه های گرافیت، گرافن اکساید سنتز شده، گرافن اکساید احیا شده زیر نور UV به همراه دما را در محدوده ی طول موج های Cm⁻¹

است و همچنین پیک مربوط به پیوند C=C در طول موج ^۲-Cm ۱۹۲۰ از شدت بیشتری برخوردار می باشد که می تواند دلیلی بر احیای گرافن اکساید سنتز شده باشد [۲۰–۱۸]. دلیل این احیا تحت تاثیر نور UV و دما بدین صورت می باشد، ازآن جا که گرافن اکساید در رده ی مواد نیمه هادی قرار می گیرد، لذا با قرار گیری تحت نور UV، الکترون آزاد ایجاد شده که این الکترون ها می توانند در فرآیند اکسیداسیون و احیا شرکت نمایند. علاوه بر این با قرار گیری تحت اتمسفر آرگون، با افزایش دما اکسیژن تعادلی کاهش یافته که می تواند گروه های عاملی را از سطح جدا سازد [۲].



شکل(۴):طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR از نمونه های: (الف): گرافیت، (ب):گرافن اکساید و (ج): گرافن اکساید احیا شده

بررسی های انجام شده در آنالیز FTIR و XRD نشان دهند ه ی کاهش گروه های عاملی در سطح گرافن اکساید و تبدیل شدن به گرافن اکساید احیا شده می باشد،که با توجه به بررسی های انجام شده با کاهش گروهای عاملی می توان هدایت الکتریکی را افزایش داد[۴].

RGO-ZnO,RGO-ZnO, بورسی میزان باند گپ-RGO-ZnO,RGO-ZnO, RGO, 2nO, TiO2 TiO2

به دلیل اینکه باند گپ نانو ذرات سنتز شده می توانند بر روی خواص الکتریکی نمونه های ساخته شده موثر باشد لذا میزان باند گپ تمامی نانو ذرات با استفاده از طیف سنجی DRS-UV مورد ارزیابی قرار گرفت. شکل ۵ نشان دهنده ی منحنی های مقایسه ای ²α بر حسب Eg ،نانو ذرات و نانو کامپوزیت های سنتز شده می باشد که با ترسیم خط مماس بر منحنی و روش تاک پلات می توان میزان باندگپ را محاسبه نمود. میزان باند گپ محاسبه شده برای این نمونه ها در جدول ۱ آورده شده است.

همان طور که در جدول ۱ مشاهده می گردد باند گپ نمونه های TiO₂ و ToD به ترتیب ۳/۲۵ev، ۳/۲۵ev است که بسیار نزدیک به هم بوده اند ،همچنین باند گپ گرافن اکساید احیا شده حدود ۱/۴۳ev است که بسیار کمتر از TiO₂ و ToD است. با توجه به میزان باند گپ نانو ذرات و با توجه به بررسی های نارایان⁶و همکارانش [۲۲]، انتظار می رود با افزودن RGO به مشاهده است میزان باند گپ On در حضور RGO از ۳/۳۰ به مشاهده است میزان باند گپ On در حضور RGO از ۳/۳۰ به کامپوزیت RGO-ZnO میزان باند گپ از ۲/۲۲ به ۲/۲۱ کاهش یافت که با توجه به ثابت بودن RGO-ZnO در هر دو نانو کامپوزیت این کاهش باند گپ به افزودن نانو ذرات Cio به نانو در نانو درات RGO-ZnO میزان باند گپ از ۲/۲۲ به ۲/۱۱ کاهش یافت که با توجه به ثابت بودن RGO-ZnO در هر دو نانو نانو درات RGO-ZnO میزان باند گپ از ۲/۲۲ به ۲/۱۱ کاهش مناور کامپوزیت این کاهش باند گپ به افزودن نانو ذرات RGO-Tio به نانو در می شود. علت این امر این است که با توجه به اینکه در طی منظور کلسینه کردن نانو ذرات Cio تروی RGO-ZnO، به منظور کلسینه کردن نانو ذرات RGO-ZnO، در ماقرار جدید در بین باند هدایت و باند ظرفیت گردیده که در مجموع باعث کاهش باند گپ می گردد.

گرفته، احتمالا دوپ یون های +Ti⁴ به درون شبکه ZnO احتمال وقوع داشته واین موضوع می تواند باعث تشکیل سطوح فرمی



شکل (۵): آنالیز DRSUV نانو ذرات و نانو کامپوزیت های RGO-ZnO و RGO-ZnO و RGO-ZnO

۳–۴– بررسی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونه های ,RGO-ZnO,RGO-ZnO-TiO وRGO وfrequency و متحنی مقاومت بر حسب frequency شکل ۶ نشان دهنده ی منحنی مقاومت بر حسب 10log می باشد، همان طور که قابل مشاهده است با کاهش گروه های عاملی گرافن اکساید(GO) و تبدیل به گرافن اکساید احیا شده (RGO) هدایت الکتریکی

جدول(۱):مقایسه میزان باند گپ نانو ذرات و کامپوزیت های RGO-ZnO و RGO-ZnO-TiO2

نمونه	TiO ₂	ZnO	RGO	RGO- ZnO	RGO- ZnO- TiO ₂
باندگپ (ev)	٣/٢٥	٣/٣٠	۱/۴۳	٣/٢٢	٣/١١

افزایش یافته است.علت این امر وجود گروه های عاملی اکسیژن داری همچون کربوکسیل-اپوکسید و هیدورکسیل هایی است که دارای پیوند کووالانسی به سطح بوده اند که باعث ایجاد الکترون های مقید و در نتیجه کاهش هدایت الکتریکی می شوند. همچنین در پژوهشی که توسط نوربخش و همکاران [۲۳] انجام گرفته شد، نشان داده شد که این گروه های عاملی نقش عایق را بازی می کنند. لذا با کاهش گروه های عاملی می توان به افزایش هدایت الکتریکی کمک نمود.





شکل ۷ نشان دهنده طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونههای ZnO و RGO-ZnO میباشد که همان طور که قابل مشاهده است حضور RGO در نانو کامپوزیت مشاهده است مقاومت نانو ذرات RGO-ZnO(NP، نقش مثبتی در جهت کاهش مقاومت نانو ذرات ZnO نشان دهد، که یکی از علل کاهش مقاومت را می توان نقش مثبت RGO در کاهش باند گپ ZnO و همچنین جلو گیری از بازتر کیب الکترون و حفره ایجاد شده در نانو ذرات ZnO دانست [۸ و ۲۲].





شکل ۸ نشان دهنده ی مقایسه طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی منحنی های نایکویست و مقاومت بر حسب فرکانس از دو نمونه RGO-ZnO و RGO-ZnO-TiO می باشد. همان طور که قابل مشاهده است نانو کامپوزیت همان طور که قابل مشاهده است نانو کامپوزیت کامپوزیت RGO-ZnO دارای مقاومت بیشتری نسبت به نانو کامپوزیت RGO-ZnO می باشد. باتوجه به ثابت بودن RGO-ZnO در این دو نانو کامپوزیت این افزایش مقاومت به افزودن نانو ذرات TiO نسبت داده می شود.

برای بررسی های بیشتر مدار معادل های مربوط به نمونه RGO-ZnO, RGO- ZnO(NP)-TiO₂(NP) با استفاده از نرم افزار ZView رسم گردید وبه همراه شماتیکی از نمونه ها به ترتیب در شکلهای ۹ و ۱۰آورده شده است. همچنین دادههای مربوط به طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در جدول ۲ آورده شده است.



RGO- ZnO(NP): مدار معادل های مربوط به نمونه -(NP): مدار معادل های مربوط به نمونه -(TiO₂(NP)



شکل(۱۰): مدار معادل های مربوط به نمونه(NP): مدار معادل های مربوط به نمونه

با توجه به داده های جدول ۲، Rs مربوط به مقاومت محلول بوده و با توجه به ثابت بودن محلول در تمامی آزمایش ها میزان Rs تقریبا ثابت بوده است. همان طور که از مدار معادل دو نمونه و داده های جدول قابل مشاهده می باشد، هر دو نمونه دارای مقاومت خازنی (CPE1) و مقاومت انتقال بار (R1) می باشند که مربوط به لایه COE7) و مقاومت انتقال بار (R1) می باشند که نانو ذرات CIO2، جهت تطابق گراف پیشنهادی نرم افزار wive با دادههای نمونه باز هم یک مقاومت خازنی (CPE2) و یک مقاومت انتقال بار (R2) دیگر به مدار افزوده شده است که همان طور که مشاهد می گردد علاوه بر افزوده شده است که همان بار و خازنی جدید(CPE2,R2)، میزان (CPE1,R1) نیز افزایش یافته است و در کل باعث افزایش مقاومت کلی مدار از Ω

R2 (Ω) Sample $Rs(\Omega)$ CPE1 (F) $R1(\Omega)$ CPE2 (F) ٩/٨١ 1/11*1.-0 ۵/۷۳۰*۱۰۵ 1/4.*1.-0 YOAV RGO-ZnO(NP)-TiO2(NP) 9/09 4/98*9-1. T+111 RGO-ZnO _ _

جدول (۲): داده های مربوط به طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونه های RGO-ZnO,RGO-ZnO-TiO₂

پژوهش، میزان سطح انرژی باند هدایت این سه ماده به ترتیب RGO(-4.42)<TiO₂(-4.2)<ZnO(-4.05) و میزان سطح انرژی برای تعیین علت این افزایش مقاومت، به بررسی مکانیزم باندگپ پرداخته می شود. مطالعات کتابخانه ای بر روی باند ظرفیت (VB)⁹و باند هدایت (CB)^۷ سه ماده ی مورد بررسی در این (٢)

باند ظرفیت به ترتییب، TiO₂(-7.4)<ZnO(-7.25) می باشد [۵و ۱۱].

شکل ۱۱ شماتیکی از مقایسه این سطوح انرژی را نشان می دهد. با توجه به این مکانیزم زمانی که در کامپوزیت RGO-ZnO به دلیل بالاتر بودن سطح انرژی ZnO نسبت به RGO، انتقال الکترون می تواند به راحتی از باند هدایت ZnO به عنوان لایه صورت بپذیرد (شکل ۱۱–الف) اما زمانی که TiO به عنوان لایه تسوم قرار می گیرد، به دلیل پایین تر بودن سطح انرژی TiO2 نسبت به ZnO، انتقال الکترون با یک مانع رو به رو می شود و مانند سدی عایق عمل می کند و باعث افزایش مقاومت می گردد (شکل ۱۱–ب).



برای غلبه بر این سد انرژی، نیاز است که به الکترون انرژی داده شود. این انرژی می تواند به شکل گرما یا امواج الکترومغناطیسی باشد. همچنین امواج الکترومغناطیسی نیز دارای انرژی هستند. انرژی امواج الکترومغناطیسی بر حسب طول موج آنها مطابق با رابطه ۲ قابل محاسبه است.

رابطه پلانک: $\mathrm{E}=\mathrm{h.c}/\lambda$

در این رابطه، E انرژی موج (j)، (h) یک عدد ثابت به نام ثابت پلانک، c سرعت نور (m/s) و λ طول موج نور (m) است. همان طور که در این رابطه مشاهده می گردد، انرژی هر موج، با طول موج آن رابطه عکس دارد .

باتوجه به مطالب بیان شده تا این مرحله، با ایجاد انرژی در یک نیمه رسانا توسط نور UV، می توان به تحریک و حرکت الکترون ها و در نتیجه ایجاد جریان و کاهش مقاومت کمک نمود. با توجه به مطالعات فوق، علت بالا بودن میزان مقاومت نمونه RGO-ZnO-TiO₂ در مقایسه با RGO-ZnO به سد پتانسیل ایجاد شده مربوط می گردد.جهت اثبات این موضوع، این نمونه تحت نور UV قرار گرفت.



RGO- شکل (۱۲): طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت ZnO-TiO₂

شکل ۱۲، مقایسه ای از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت RGO-ZnO-TiO₂ را در حضور و عدم حضور نور UV نشان می دهد. همان طور که قابل مشاهده است با قرار گیری تحت نور UV، مقاومت نمونه به شدت کاهش یافته است که می تواند اثباتی بر غلبه الکترون ها بر سد مقاوم در حضور نور UV به عنوان عاملی خارجی باشد.

RGO-ZnO- بررسی ریز ساختاری نانو کامپوزیت -RGO-ZnO TiO2

باتوجه به اهمیت چگالی سطح ذرات بر مقاومت (هر چه چگالی کمتر بوده و درنتیجه فضای خالی بیشتر باشد،این فضاهای خالی می توانند نقش عایق را بازی کرده و هدایت الکتریکی را کاهش دهند) لذا تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) از سطح و مقطع عرضی به همراه طیف میدانی (EDX) از سطح و مقطع عرضی به همراه طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس (EDX) از دو قسمت نمونه فوتوآند (NP) در (NP) از دو شکل های ۱۳ و ۱۴ نشان داه شده است.

همان طور که قابل مشاهده می باشد بر روی سطح نمونه ذرات TiO₂ با نظم خاصی پوشش داده شده اند و در بعضی از نقاط حضور ذرات الیافی شکل RGO قابل مشاهده است.



شکل (۱۳): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (-FE EDX) از سطح نمونه RGO-ZnO-TiO2 به همراه SEM

ضخامت نمونه پوشش داده شده در حدود ۱/۴۳ میکرومتر بوده است که در شکل ۱۴ به خوبی مشخص شده است، حضورعناصر Ti و Zn و O نشان دهنده ی ترکیبات TiO₂ و ZnO و همچنین C

به حضور گرافن اکساید در آزمون توزیع انرژی پرتوی ایکس (EDX) مربوط میشود. همچنین آنالیز XRD در شکل ۳ نیز موید تشکیل فازهای مربوط به RGO، ZnO و TiO می باشد. نتیجه دیگر که از این تصویر حاصل میشود، حضور پوشش یکنواخت و کاملا پوشیده شده بر سطح شیشه است.



شکل(۱۴): نمودار EDX به همراه تصویر (FE-SEM) از دو نقطه: (الف): نزدیک و (ب): دور تر به سطح شیشه و مقطع عرضی نمونه RGO-ZnO نزدیک (NP)-TiO₂ (NP)

۴- نتیجه گیری

در تحقیق حاضرگرافن اکساید با روش هامر اصلاح شده سنتز شده و سپس تحت نور UV و دما احیا گردید و در ادامه خاصیت الکتریکی RGO و GO با یکدیگر مقایسه گردید که RGO با کاهش گروههای عاملی هدایت الکتریکی بیشتری را نشان داد .با توجه به بررسیهای انجام گرفته بر روی میزان باند گپ نانو ذرات سنتز شده، RGO دارای باند گپ بسیار کمتری

- [4] S. Ryong Kim, M. Khaled Parvez & M. Chhowalla, "UV- reduction of grapheme oxide and its application as an interfacial layer to reduce the back - transport reactions in dye sensitized solar cells", Chemical physical letters, Vol. 483, pp. 124-127, 2009.
- [5] X. Liu, L. Pan, T. Lv & Z. Sun, "Investigation of photocatalytic activities over ZnO-TiO₂- reduced graphene oxide composite synthesized via microwave -assisted reaction", Journal of colloid and interface science, Vol. 394, pp. 441-444, 2013.
- [6] G. Williams, B. Seger & Prashant V. Kamat, "TiO₂-Graphene Nanocomposites. UV-Assisted Photocatalytic Reduction of Graphene Oxide", ACS Nano, Vol. 7, pp. 1487–1491, 2008.
- [7] T. Xu, L. Zhang & H. Cheng, "Significantly enhanced photocatalytic performance of ZnO via graphene hybridization and the mechanism study", Catal. B: Environ., Vol. 101, pp. 382–387, 2011.
- [8] X. Liu, L. Pan, Q. Zhao, T. Lv, G. Zhu, T. Chen, T. Lu, Z. Sun & C. Sun, "UV- assisted photocatalytic synthesis of ZnO – reduced graphene oxide composite with enhanced photocatalytic activity in reduction of Cr(VI)", Chemical engineering journal, Vol. 183, pp. 238-243, 2012.
- [9] Nekoubin, H. Ghayour Najafabadi & M. Nasr Esfahani, "An Illustration of Photocatalytic Properties of ZnOnanorods array Films", J. Adv. Mater. Process, Vol. 1, No. 1, pp. 39-45, 2013.
- [10] A. Anish Madhavan, A. Mohandas, A. Licciulli, K. P. Sanosh, P. Praveen, R. Jayakumar, S. V. Nair, A. Sreekumaran Nair & A. Balakrishnan, "Electro spun continuous nano fibres based on TiO₂-ZnO-Graphene composite", RSC Advances, 2013.
- [11]F. Tuz Johra & W. Gwang Jung, "RGO- TiO₂-ZnO composite: Synthesis, characterization and application to photo catalysis", Applied catalysis A: General, Vol. 491, pp. 52-57, 2015.
- [12] H. Tian, H. Fan, H. Guo & N. Song, "Solutionbased synthesis of ZnO/carbon nanostructure by chemical coupling for high performance gas sensors", Sensor and Actuator, Vol. 195B, pp. 132-139, 2014.

نسبت به ZnO و TiO2 بوده، لذا به بررسی تاثیر افزودن RGO به ZnO پرداخته شد و نتایج نشان دادند افزودن RGO نه تنها باعث کاهش باند گي ZnO از ۳/۳۰ به ۳/۲۲ شده است بلکه باعث افزایش هدایت الکتریکی نیز گردیده است. در نهایت به بررسی تاثیر افزودن TiO₂ به نانو کامبوزیت RGO-ZnO یرداخته شد که افزودن TiO₂ نیز باعث کاهش باند گپ این نانو کامیوزیت از ۳/۲۲ به ۳/۱۱ شده است، اما با توجه به مدارهای معادل این دو نانو کامبوزیت، با افزودن نانو ذرات TiO₂ به نمونه RGO-ZnO بك مقاومت خازني و بك مقاومت انتقال بار به مدار افزوده شد که باعث افزایش مقاومت کل و در نتیجه كاهش هدايت الكتريكي مدار شده است. با بررسي مكانيزم اين يديده ابن نتبجه حاصل شد كه، علت بالا بودن مبزان مقاومت نمونه RGO-ZnO-TiO₂ در مقایسه با RGO-ZnO به سد یتانسیل ایجاد شده به دلیل بالاتر بودن سطح انرژی ZnO نسبت به TiO₂ مربوط می گردد، که با دادن انرژی از طریق نور UV می توان بر این سد پتانسیل غلبه نمود و هدایت الکتریکی را افزایش داد. همچنین از این نمونه بررسیهای فازی و ریز ساختاری صورت گرفت که این بررسی ها به خوبی حضور هم زمان این نانو ذرات را در نانو کامبوزیت RGO-ZnO-TiO₂ نشان دادند.

۵- مراجع

- Y. Zhu, S. Murali, W. Cai, X. Li, J. Won Suk, J. R. Potts & R. S. Ruoff, "Graphene and graphene oxide: Synthesis, Properties, and applications", Adv. Materials (2010)1-19.
- [2] J. Guerrero Contreras & F. Caballero Briones, "Graphene oxide powders with different oxidation degree, prepared by synthesis variation of the Hummers method", Materials chemistry and physics, pp. 1-12, 2015.

[۳] ت. آقاجانی، "بررسی رفتار الکتروشیمیایی و کاربرد الکترود طلای اصلاح شده بوسیله گرافن عامل دار شده در لبه ها"، ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۱. [23] A. Nourbakhsh, S. abbaspour, M. Masoud, S. N. Mirsatari, A. vahedi, K. J. D. Mackenzie, "Photocatalytic properties of mesoporous TiO₂ nanocomposites modified with carbon nanotubes and copper", Ceramics International, Vol. 42, pp. 11901-11906, 2016.

[۲۴] آ. فتاح الحسینی و ا. ایمان طلب، "بررسی رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ کم کربن در یک محلول قلیایی با روش موت- شاتکی و روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی"، فصلنامه علمی پژوهشی فرایند های نوین در مهندسی مواد،شماره ۲، تابستان، ۱۳۹۳.

۶- پی نوشت

- [1] Xu
- [2] Liu
- [3] Madhavan
- [4] Johra
- [5] Narayan
- [6] valance band
- [7] conduction band

- [13]S. S. Kanmani & K. Ramachandran, "Synthesis and characterization of TiO₂/ZnO core/shell nanomaterials for solar cell applications", Renewable Energy, Vol. 43, pp. 149-156, 2012.
- [14] Measurements of Band Gap in Compound Semiconductors- Band Gap Determination from Diffuse Reflectance Spectra, Shimadzu Application News, 2013.
- [15] A. Fakhri, "Adsorption characteristics of graphene oxide as a solid adsorbent for aniline removal from aqueous solutions: Kinetics, thermodynamics and mechanism studies", Journal of Saudi Chemical Society, 2013.
- [16]S. Debnath, A. Maity & K. Pillay, "Impact of process parameters on removal of Congo red by graphene oxide from aqueous solution", Journal of Environmental Chemical Engineering, Vol. 2, pp. 260-272, 2014.
- [17] L. H. Tang, Y. Wang, Y. M. Li, H. B. Feng, J. Lu & J. H. Li, "Preparation, Structure, and Electrochemical Properties of Reduced Graphene Sheet Films", Adv. Funct. Mater, Vol. 19, pp. 2782–2789, 2009.
- [18] Li, Y., et al., "Comparative study of methylene blue dye adsorption onto activated carbon, graphene oxide, and carbon nanotubes", Chemical Engineering Research and Design, Vol. 91, pp. 361-368, 2013.
- [19] P. Sharma & M. R. Das, "Removal of a cationic dye from aqueous solution using graphene oxide nanosheets: investigation of adsorption parameters", Journal of Chemical & Engineering Data, Vol. 58, pp. 151-158, 2012.
- [20] Li, Y., et al., "Preparation of ceria nanoparticles supported on carbon nanotubes", Materials research bulletin, Vol. 37, pp. 313-318, 2002.
- [21] S. Pei, H. Ming Cheng, "The reduction of graphene oxide", Carbon, Vol. 50, pp. 3210–3228, 2012.
- [22]G. Nisha Narayanan, G. Deepan P & A. Karthigeyan, "Structural and optical properties of zinc oxide- reduced graphene oxide nanocomposite thin film prepared by hydrothermal method", International journal of chem tech research, Vol. 3, pp. 1065-1071, 2015.

The effect of adding TiO₂ nanoparticle on the electrical conductivity of RGO-ZnO nanocomposite

Najme Lotfian¹, Amirabbas Nourbakhsh^{2*}, Parisa Mashayekhi³, Sara Abbaspour⁴, Seyed Mehdi Mirhadi⁵, Saied Jabar zare⁶

1- Ph.D. Student, Young Researchers and Elite Club, Shahreza Branch, Islamic Azad university, Shahreza, Iran

2- Associate Professor, Department of Materials Science and Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

3- M.Sc. Student, Department of Materials Science and Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

4- Ph.D. Student, Advanced Materials Rsearch Center, Department of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad university, Najafabad, Iran

5- Lecturer, Student, Department of Materials Science and Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

6- Lecturer, Advanced Materials Rsearch Center, Department of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad university, Najafabad, Iran

*Corresponding author: anourbakhs@yahoo.com

Abstract

This present research was related to electrical conductivity of RGO-ZnO-TiO₂ nanocomposite in comparison RGO-ZnO nanocomposite. In order to carry out this research, at first graphene oxide was synthesized by using modified Hummer method and reduction of graphene oxide (reduced graphene oxide(RGO), was done by UV light and temperature. TiO₂ and ZnO nanoparticles were synthesized by sol-gel method. XRD, FTIR and DRSUV were used to investigate these nanoparticles.

For sample preparation, dip coating method was used and all particles were coated on the surface of FTO respectively. for investigation of adding TiO_2 nanoparticles on the electrical conductivity and amount of band gap of RGO-ZnO nanocomposite, electrochemical impedance spectroscopy and talc plot were used.

The results of comparison between these 2 samples showed that adding TiO₂ nanoparticle to RGO-ZnO nanocomposite reduced band gap from 3.22 to 3.11 and increase resistance from $2.8*10^4\Omega$ to $5.76*10^4\Omega$, with study of level energy of RGO, ZnO and TiO₂ nanoparticles, the reason of increasing resistance related to higher ZnO energy level in comparison to TiO₂ energy level and electron Inability to overcome of this level energy in the absence of UV light .with putting this sample under UV light could be reduced this resistance.

Keywords:

nanocomposite, RGO-ZnO, electrical conductivity, TiO₂, electrochemical impedance spectroscopy.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Najme Lotfian, Amirabbas Nourbakhsh, Parisa Mashayekhi, Sara Abbaspour, Seyed Mehdi Mirhadi, Saied Jabar zare, The effect of adding TiO2 nanoparticle on the electrical conductivity of RGO-ZnO nanocomposite, in Persian, New Process in Material Engineering, 2018, 12(2), 27-40.